(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-7265

(43)公開日 平成7年(1995)1月10日

技術表示箇所		FΙ	庁内整理番号	⊒	識別記号		(51) Int.Cl. ⁶
(大)的大八、四八八		1 1	7511-4E	В	pacture.	3/42	H05K
			7511-4E	Б			
						5/44	C 0 9 D
					PR\$		
				Z		1/00	G03F
			9443-4E	E		3/06	H05K
未請求 請求項の数4 OL (全 15 頁)	7	審查請求					
000003322	. 0	(71) 出願人		14	持順平5-1431		(21)出願番号
大日本塗料株式会社	7						
大阪府大阪市此花区西九条6丁目1番124	5		月15日) 6 J	4成5年(1993		(22)出顧日
号							
000004455		(71) 出願人					
日立化成工業株式会社		(11) [[1]					
東京都新宿区西新宿2丁目1番1号							
		(70) Sensete					
立木祭雄		(72)発明者					
茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化	-						
成工業株式会社茨城研究所内	Æ						
弁理士 若林 邦彦	. #	(74)代理人					
最終頁に続く							

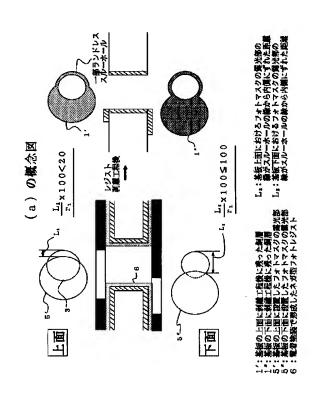
(54) 【発明の名称】 プリント配線板の製造法

(57)【要約】

【目的】 フォトマスクの位置ずれ裕度が広く、かつ、 ランドレススルーホールが形成できるプリント配線板の 製造法を提供する。

【構成】 スルーホールの内壁及び基板の表面に銅層を有する基板に、ネガ型感光性電着塗料樹脂組成物を電着塗装し、フォトレジストを形成したのち、その表面にフォトマスクを設置し、それを介して露光する際に、

(a) 基板の一方の面でフォトマスクの露光部がスルーホールに対して20%未満でずれている場合、反対の面では100%以下、(b) 基板の一方の面で20~50%ずれている場合、反対の面では50%以下ずれてフォトマスクを設置し、露光を行い、次いで現像を行い、レジストパターンを形成し、さらに露出している銅をエッチングし、最後にレジスト剥離工程を経てスルーホールを有するプリント配線板の製造法。



(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 スルーホールの内壁及び基板の表面に銅層を有する基板(厚み1.30mm以下)に、ネガ型感光性電着塗料樹脂組成物を電着塗装し、フォトレジストを形成したのち、その表面にフォトマスクを設置し、それを介して露光、現像を行い、レジストパターンを形成し、さらに露出している銅をエッチングし、最後にレジスト剥離工程を経てスルーホールを有するプリント配線板を製造する方法において、フォトマスク中のスルーホールに対応する露光部の径が、対応する実際のスルーホール径に対して1.00~3.00倍の範囲であるフォトマスクを用い、かつ、フォトマスクの設置条件を、

1

(a) フォトレジストを形成した前記基板の片面にある一つのスルーホールに対しフォトマスク中の前記スルーホールに対応する露光部の縁が前記スルーホールの縁から前記スルーホールの内側に向かって前記スルーホール径の20%未満に相当する距離の分ずらしてフォトマスクを設置し、フォトレジストを形成した前記基板のもう一方の面では、フォトマスク中の前記スルーホールに対応する露光部の縁が前記スルーホールの縁から前記スルーホールの内側に向かって前記スルーホール径の100%以下に相当する距離の分ずらしてフォトマスクを設置する及び/又は

(b) フォトレジストを形成した前記基板の片面にある一つのスルーホールに対しフォトマスク中の前記スルーホールに対応する露光部の縁が前記スルーホールの縁から前記スルーホールの内側に向かって前記スルーホール径の20~50%に相当する距離の分ずらしてフォトマスク(上記(a)におけるフォトマスクとは異なる)を設置し、フォトレジストを形成した前記基板のもう一方の面ではフォトマスク中の前記スルーホールに対応する露光部の縁が前記スルーホールの縁から前記スルーホールの内側に向かって前記スルーホール径の50%以下に相当する距離の分ずらしてフォトマスクを設置することを特徴とするプリント配線板の製造法。

【請求項2】 スルーホールの径が0.01~10.0 mmである請求項1記載のプリント配線板の製造法。

【請求項3】 フォトマスクを介して行う露光を、基板に対し斜めに光を照射する方式とする請求項1又は2記載のプリント配線板の製造法。

【請求項4】 ネガ型感光性電着塗料樹脂組成物が、

- (i) アクリル酸及び/又はメタクリル酸を共重合した酸価20~300のポリマーを塩基性の有機化合物で中和したポリマー、
- (ii) 光重合性不飽和結合を分子内に2個以上有する非 水溶性モノマー

並びに

(iii) 非水溶性光開始剤

を含有してなるネガ型感光性電着塗料樹脂組成物である 請求項1、2又は3記載のプリント配線板の製造法。 2

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、プリント配線板の製造 法に関する。

[0002]

【従来の技術】スルーホールを有するプリント配線板の 製造には、通常、銅めっきされたスルーホールを有する 基板の表面にフォトレジストを形成し、次いでフォトマ スクを介して露光、現像、エッチング、レジスト剥離工 程を経て行っている。従来から、フォトレジストの形成 は、感光性フィルムを積層する方法、即ち、テンティン グ法が主流であった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記のフォトマスクを介して露光する工程では、基板上のスルーホールとフォトマスク中のそのスルーホールに対応する露光部の位置とが正しく合っていないと、本来レジストとして残すべきスルーホール孔を覆っているテンティング部位の一部が露光されずに未硬化のままになり、その後の現像でその部分が除去されてしまう。その結果、エッチング工程で、エッチング液がレジストの破れた部位からスルーホール内に侵入し、スルーホール内壁の銅の一部又は全部が除去されてしまい、導通不良という問題が発生する。もちろん、基板上のたとえ1つのスルーホールでも導通不良となれば、その基板は使用できない。したがって、フォトマスクは正しく位置合わせをしなければならないことになる。

【0004】一方、最近、プリント配線板の高密度化、高精細化が進むにしたがい、銅のライン幅が細くなると同様に、スルーホール径も次第に小さくなってきている。このような状況になると、フォトマスクの位置合わせは、極めて高精度が要求されるようになった。

【0005】しかし、実際のプリント配線板の製造ラインにおいては、フォトマスクの材質上から、使用時の環境の温度によって、フォトマスク自体に熱膨張や熱収縮があり、またその寸法変化も、フォトマスクの場所によって必ずしも一様でないこと、また、一枚の基板上のスルーホールの径は様々で、かつスルーホールの個数も極めて多いこと等の理由で、全てのスルーホールに対して適確に高精度でフォトマスクを設定することは至難となってきた。

【0006】そのため従来から、実際のスルーホール径に対して、それに対応するフォトマスクの露光部の径をかなり大きく設定しておき、多少フォトマスクの位置がずれても、スルーホール孔を覆うフォトレジストの部位には十分光が当たるように工夫して対処しているのが実体である。

【0007】しかしこの方法では、スルーホールの周囲に不要な幅広いランドが形成されることになるため、今 50 後のランドレスもしくは小径ランド化への要求には逆行 .3

することになる。一方、プリント配線板の高密度化に対応すべく、フォトレジストを電着塗装で形成する方式が、最近注目を集めている。中でも、ポジ型のフォトレジストを電着塗装で形成する方法は、原理的にスルーホール内を露光しなくても、スルーホール内壁の銅をレジストで被覆できることから、スルーホールを有するプリント配線板の製造に有利といわれている。

【0008】しかし、この方法も、フォトマスクの位置ずれに対しては極めて敏感で、裕度は狭いという問題があった。すなわち、フォトマスクの位置がずれて(ポジ型の場合には、前述のネガ型の場合とは反対に、スルーホールに対応するフォトマスクの部位は露光を遮断している)、わずかでもスルーホール内に光が漏れるとスルーホール内のフォトレジストの一部もしくは全部が分解し、現像により除去されてしまう。この結果、エッチング時に、スルーホール内壁の露出した銅は除去されてしまい、やはり導通不良をきたすことになる。

【0009】以上述べたように、従来の技術では、フォトマスクの位置ずれに対して極めて弱いという欠点があった。また、今後、プリント配線板の高密度化、高精細化が求められる中で、完全又は一部ランドレスのスルーホール形成の要求を満足できないという致命的問題があった。このような背景の中で、スルーホール径に対して極端に大きなフォトマスクの露光部位を設定することなく、しかも、フォトマスクの位置ずれに対しても裕度の広い製造技術が求められるようになった。

[0010]

【課題を解決するための手段】そこで本発明者らが鋭意検討した結果、ネガ型フォトレジストを電着塗装で形成し、さらにフォトマスクのスルーホールに対応する露光部径を該スルーホール径の1.00~3.00倍の範囲としたフォトマスクを介して露光を行い、またその際に用いるスルーホールを有する基板の厚みを1.30m以下とした上で、フォトマスクの設置条件を特定の適切な範囲内にとすることで前述のランドレスや小径ランド化が可能となり、しかもこの方法によれば、従来に比べてフォトマスクの位置ずれ裕度を充分に保ってプリント配線板を製造できることを見い出し、本発明に至った。

【0011】すなわち本発明は、スルーホールの内壁及び基板の表面に銅層を有する基板(厚み1.30mm以下)に、ネガ型感光性電着塗料樹脂組成物を電着塗装し、フォトレジストを形成したのち、その表面にフォトマスクを設置し、それを介して露光、現像を行い、レジストパターンを形成し、さらに露出している銅をエッチングし、最後にレジスト剥離工程を経てスルーホールを有するプリント配線板を製造する方法において、フォトマスク中のスルーホールに対応する露光部の径が、対応する実際のスルーホール径に対して1.00~3.00倍の範囲であるフォトマスクを用い、かつ、フォトマスクの設置条件を、(a)フォトレジストを形成した前記

4

基板の片面にある一つのスルーホールに対しフォトマス ク中の前記スルーホールに対応する露光部の縁が前記ス ルーホールの縁から前記スルーホールの内側に向かって 前記スルーホール径の20%未満に相当する距離の分ず らしてフォトマスクを設置し、フォトレジストを形成し た前記基板のもう一方の面では、フォトマスク中の前記 スルーホールに対応する露光部の縁が前記スルーホール の縁から前記スルーホールの内側に向かって前記スルー ホール径の100%以下に相当する距離の分ずらしてフ ォトマスクを設置する及び/又は(b) フォトレジスト を形成した前記基板の片面にある一つのスルーホールに 対しフォトマスク中の前記スルーホールに対応する露光 部の縁が前記スルーホールの縁から前記スルーホールの 内側に向かって前記スルーホール径の20~50%に相 当する距離の分ずらしてフォトマスク(上記(a)にお けるフォトマスクとは異なる)を設置し、フォトレジス トを形成した前記基板のもう一方の面ではフォトマスク 中の前記スルーホールに対応する露光部の縁が前記スル ーホールの縁から前記スルーホールの内側に向かって前 記スルーホール径の50%以下に相当する距離の分ずら してフォトマスクを設置することを特徴とするプリント 配線板の製造法に関する。

【0012】本発明には、①基板の片面で、フォトマスクのスルーホールに対応する露光部(光を透過する領域)の縁の位置が、スルーホールの縁から内側にわずかにずれた程度であれば、その基板の反対側の面では、スルーホールからほぼ完全にフォトマスクがずれて、その基板の反対側の面からはスルーホール内にほとんど光が照射されなくても、スルーホール内の信頼性が確保でき、また、②基板の両面で、フォトマスクのスルーホールに対応する露光部の縁の位置が、スルーホールの縁から内側に向かって、スルーホール径の最大50%に相当する距離の分ずれても、スルーホール内の信頼性が確保できるという、フォトマスクの位置ずれ裕度が極めて広いという特長を有している。

【0013】フォトマスクの位置ずれ裕度が広がることにより、高価なフォトマスクの材質にこだわる必要がなくなること、フォトマスクの位置合わせ時間が著しく短縮される等の効果が得られる。

【0014】また、①の場合、フォトマスクの露光部が実際のスルーホールから完全にずれた面でのスルーホールは完全にランドレスとなり(図5参照)、その他のフォトマスクが位置ずれしたスルーホールでは、一部ランドレスが達成できる(図2参照)という特長を有している。もちろん、本発明のフォトマスクの露光部径は、対応するスルーホール径の1.00~3.00倍の範囲なので、小径ランドも可能となる。

する実際のスルーホール径に対して1.00~3.00 【0015】以下、本発明について詳細に説明する。ま 倍の範囲であるフォトマスクを用い、かつ、フォトマス ず、本発明における基板について説明する。本発明にお クの設置条件を、(a)フォトレジストを形成した前記 50 ける基板は、スルーホールの内壁及び基板の表面に銅層

を有する基板であれば特に制限はない。例えば、アルミ ナ、セラミックーエポキシ樹脂、ガラスーエポキシ樹 脂、紙-フェノール樹脂、ポリイミドフィルム、ポリエ ステルフィルム等の絶縁板の表面に、銅箔をはり合わせ たり、銅めっきを施したり、蒸着やスパッタリングわ行 ったり、それらを組み合わせるなどして、銅の層を設け たものが好適である。またスルーホールは、ドリルなど を用いて機械的に、エッチング等により化学的に、レー ザーによる穴あけ等によって、基板に穴をあけ、その内 壁に、めっきやスパッタリング等の方法によって銅の層 を形成して得ることができる。スルーホールを設ける工 程は、前述した絶縁板の段階でもよく、もちろん、絶縁 板の表面に銅の層を形成した後でもよい。いずれにして も、スルーホールを有する基板であって、スルーホール の内壁及び基板の表面に銅層を有する基板であればよい (図1参照)。

【0016】ただし、本発明になる上記の基板の厚み (銅層を含めた全厚み、図1のr₃)は、1.30mm以 下に限定され、好ましくは、O. 80mm以下、より好ま しくはO. 50mm以下の基板が用いられる。基板の厚み が1.30mmを超えると、フォトマスクの位置ずれ裕度 が極端に狭くなる傾向(スルホール内の信頼性が低下し やすくなる)があり、逆に基板の厚みが薄くなるほどフ ォトマスクの位置ずれ裕度が広がり好ましい。

【0017】また、スルーホール径の大きさは、特に制 限されないが、0.01~10.0mmの範囲とすること が好ましく、スルホール径が小さすぎても大きすぎても フォトマスクの位置ずれ裕度が狭くなる傾向がある。本 発明でいうスルーホール径とは、図1に示すようにスル ーホール内の銅層の内側の径をさす(図1の r 1)。

【0018】次に、上記の基板表面に電着塗装するネガ 型感光性電着塗料樹脂組成物について説明する。ネガ型 フォトレジストを電着塗装で形成する場合、カチオン型 とした電着塗装液を用いてもよいが、入手容易性、安定 性、電着性、作業性等の点から、アニオン型とした電着 塗装液が好ましい。そのためアニオン型としたネガ型フ ォトレジスト用の材料としては、例えば、①カルボキシ ル基含有樹脂にメタクリル酸グリシジルやアクリル酸グ リシジルを付加反応させた樹脂、②共役ジエン重合体又 は共役ジエン共重合体に α , β -不飽和ジカルボン酸無 水物を付加し、さらにアルコール性水酸基を有する α , β-不飽和モノカルボン酸エステルを反応させた樹脂、 ③エポキシ樹脂と不飽和脂肪酸とのエステル化物におけ る脂肪酸鎖中の不飽和結合にα, β-エチレン性不飽和 二塩基酸又はその無水物を付加させた樹脂、④不飽和脂 肪酸変性の高酸価アルキド樹脂、⑤カルボキシル基含有 樹脂等の樹脂に架橋剤、光開始剤等を配合した組成物を 主成分とした材料が挙げられる。

【0019】本発明の製造法にも、このようなネガ型フ

できるが、特に光感度が高く、また、エッチング耐性の 強いネガ型フォトレジストを形成できる点、後述するフ オトマスクの位置ずれ裕度がより広げられるという点 で、(i)アクリル酸及び/又はメタクリル酸を共重合 した酸価20~300のポリマーを塩基性の有機化合物 で中和したポリマー(ii)光重合性不飽和結合を分子内 に2個以上有する非水溶性モノマー並びに(iii) 非水 溶性光開始剤を含有するネガ型感光性電着塗料樹脂組成 物を含む電着塗装液を用いることが好ましい。

【0020】以下に、上記のネガ型感光性電着塗料樹脂 組成物について詳述する。(i)の成分であるポリマー はアクリル酸及び/又はメタクリル酸を必須成分として 共重合した酸価20~300のポリマー(中和前のポリ マー) を塩基性の有機化合物で中和したポリマーであ る。アクリル酸及びメタクリル酸は単独で又は両者を組 み合わせて用いることができ、その使用量は、ポリマー の酸価が20~300の範囲となるよう適宜使用され る。ポリマーの酸価が20未満では感光性電着塗料樹脂 組成物に塩基性の有機化合物を加えた後、水を加えて水 分散させる際の水分散安定性が悪く、組成物が沈降しや すい。またポリマーの酸価が300を超えると電着膜の 外観が劣りやすい。

【0021】中和前のポリマーは、アクリル酸及び/又 はメタクリル酸と、例えば、メチルアクリレート、メチ ルメタクリレート、エチルメタクリレート、ブチルメタ クリレート、エチルアクリレート、イソプロピルアクリ レート、n-ブチルアクリレート、イソブチルアクリレ ート、n-ヘキシルアクりレート、n-オクチルアクリ レート、n-オクチルメタクリレート、n-デシルメタ クリレート、シクロヘキシルメタクリレート、2-ヒド ロキシエチルアクリレート、シクロヘキシルメタクリレ ート、アクリロニトリル、スチレン、塩化ビニル等の重 合性モノマーの少なくとも1種とを共重合することによ り得られる。中でも、メチルメタクリレートはレジスト の耐エッチング性を高めるにの好適で、中和前のポリマ ーを構成する全モノマー100重量部中、60~85重 量部使用することが好ましい。

【0022】中和前のポリマーの合成は前記の重合性モ ノマーを有機溶媒中でアゾビスイソブチロニトリル、ア ゾビスジメチルバレロニトリル、過酸化ベンゾイル等の 重合開始剤を用いて一般的な溶液重合により得ることが できる。この場合、用いる有機溶媒は電着塗料に供する ことを考えてジオキサン、エチレングリコールモノメチ ルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテ ル、エチレングリコールモノアセテート、ジエチレング リコールモノエチルエーテルアセテート等の親水性の有 機溶媒を主に用いることが好ましい。もしトルエン、キ シレン、ベンゼン等の疎水性の有機溶媒を主に用いた場 合には、ポリマー合成後、溶媒を留去して前記の親水性 オトレジスト用の材料を含む電着塗装液を用いることが 50 溶媒に置き換える必要がある。中和前のポリマーの重量

平均分子量(標準ポリスチレン換算)は5,000~150,000の範囲とすることが好ましい。5,000 未満ではレジストの機械的強度が弱くなる傾向があり、150,000を超えると電着塗装性が劣り、塗膜の外観が劣る傾向がある。

【0023】(i)成分であるポリマーの使用量は(i)成分及び(ii)成分の総量100重量部に対して50~85重量部とすることが好ましく、60~75重量部の範囲とすることがより好ましい。使用量が50重量部未満では、レジストの機械的強度が弱く、強じん性が劣る傾向があり、また85重量部を超えると(ii)成分である光重合性モノマーの割合が減って光に対する感度が低下する傾向がある。

【0024】(ii)成分である光重合性不飽和結合を分 子内に2個以上有する非水溶性モノマーとしては、例え ば、トリメチロールプロパンジ(メタ)アクリレート、 トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、テ トラメチロールメタントリ (メタ) アクリレート、テト ラメチロールメタンテトラ (メタ) アクリレート、ジペ ンタエリスリトールペンタ (メタ) アクリレート、ジペ ンタエリスリトールヘキサ (メタ) アクリレート等のエ チレングリコールを1つ以上縮合したポリエチレングリ コールを除く多価アルコールに α , β -不飽和カルボン 酸を付加して得られる化合物、トリメチロールプロパン トリグリシジルエーテルトリアクリレート、ビスフェノ ールAジグリシジルエーテルジ (メタ) アクリレート等 のグリシジル基含有化合物に α , β -不飽和カルボン酸 を付加して得られる化合物、多価カルボン酸(無水フタ ル酸等)と水酸基及びエチレン性不飽和基を有する物質 (β-ヒドロキシエチル (メタ) アクリレート等) との エステル化物、ウレタン骨格をもったウレタンジアクリ レート化合物などを用いることができる。いずれにして も、非水溶性で光照射により硬化するものであればよ い。その意味で、 (ポリ) エチレングリコールジアク リレートなどの親水性モノマーは本発明の範囲外であ る。これらは単独で又は2種類以上を組み合わせて用い られる。

【0025】(ii) 成分の使用量は、(i) 成分及び(ii) 成分の総量100重量部に対して15~50重量部の範囲とすることが好ましく、25~40重量部の範囲とすることがより好ましい。使用量が15重量部未満では光に対する感度が低下し、また50重量部を超えるとレジストがもろくなる傾向がある。

【0026】 (iii) 成分である非水溶性光開始剤としては、例えば、ベンゾフェノン、N, N'ーテトラメチルー4, 4'ージアミノベンゾフェノン、4ーメトキシー4'ージメチルアミノベンゾフェノン、2ーエチルアントラキノン、フェナントレンキノン等の芳香族ケトン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインフェニルエーテル等のベンゾインエー50

8

テル、メチルベンゾイン、エチルベンゾイン等のベンゾイン、2-(o-pprotectarrown)-4, 5-ジフェニルイミダゾール二量体、<math>2-(o-pprotectarrown)-4, 5-ジ(m-y)++シフェニル(クェニル)ー5-フェニルイミダゾール二量体などが挙げられる。これらは単独で又は2種類以上を組み合わせて用いられる。

【0027】(iii) 成分の使用量は(i) 成分及び(ii) 成分の総量100重量部に対して0.1~15重量部の範囲とすることが好ましく、0.2~10重量部の範囲とすることがより好ましい。使用量が0.1重量部未満では光に対する感度が低下する傾向があり、15重量部を超えると露光の際に組成物の表面での光吸収が増大し、内部の光硬化が不十分となる傾向がある。(ii) 成分及び(iii) 成分は非水溶性でなければならない。水溶性では他の成分と均一に混合された状態で電着塗装することが困難となる。

【0028】本発明におけるネガ型感光性電着塗料樹脂組成物には染料、顔料等の着色剤を含有させてもよい。着色剤としては、例えば、フクシン、オーラミン塩基、クリスタルバイオレット、ビクトリアピュアブルー、マラカイトグリーン、メチルオレンジ、アシッドバイオレットRRH等が用いられる。さらに、本発明のネガ型感光性電着塗料樹脂組成物には、熱重合禁止剤、可塑剤、接着促進剤、無機フィラー等を添加してもよい。

【0029】以上述べた(i)、(ii)及び(iii)成 分を含む電着塗装液を調製するには、まず(i)、(i i)及び(iii)成分を前述した親水性有機溶媒に均一に 溶解させた溶液とすることが望ましい。この場合中和前 のポリマー ((i) 成分のポリマーの前駆体) を合成す る際に用いた親水性有機溶媒をそのまま用いてもよく、 いったん合成溶媒を留去した後、別の親水性有機溶媒を 加えてもよい。また親水性有機溶媒は2種類以上でもよ い。親水性有機溶媒の使用量は(i)、(ii)及び(ii i) 成分を含む固形分100重量部に対し300重量部 以下の範囲とすることが好ましい。次に、前記の溶液に 塩基性の有機化合物を加えて中和前のポリマー中に含ま れるカルボキシル基を中和することにより、水溶化また は水分散化を容易にしたポリマー((i)成分のポリマ 一)とすることにより電着塗装液を調整することができ る。

【0030】ここで用いる塩基性の有機化合物としては特に制限はないが、例えば、トリエチルアミン、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、ジイソプロピルアミン、ジメチルアミノエタノール、モルホリン等が挙げられ、これらは単独で又は2種類以上を組み合わせて用いられる。これら塩基性の有機化合物の使用量は中和前のポリマー中のカルボキシル基1当量に対して0.3~1.0当量の範囲とすることが好ましい。0.3当量未満では電着塗装液の水分散安定性が低下する傾向があ

り、1.0当量を超えると電着塗装後の塗膜厚が薄くなり、外観が低下する傾向がある。

【0031】また、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム 等の塩基性の無機化合物は、ネガ型感光性電着塗料樹脂 組成物の加水分解を起こしやすいので使用しない方がよい

【0032】電着塗装液は、通常、ネガ型感光性電着塗料樹脂組成物に水を加えて、水に溶解もしくは分散させて電着塗装液を作製することができる。電着塗装液の固形分は5~20重量%の範囲、またpHは25℃で6.0~9.0の範囲とすることが液管理、電着性等の点から好ましい。pHを上記の好ましい範囲に合わせるために後から前記の塩基性の有機化合物を加えて調節してもよい。

【0033】ネガ型感光性電着塗料樹脂組成物を含む電着塗装液の水分散性や分散安定性を高めるために非イオン性界面活性剤、陽イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤等を適宜加えることもできる。電着塗装時の塗布量を多くするために、トルエン、キシレン、2ーエチルへキシルアルコール等の疎水性溶媒も適宜加えることができる。

【0034】このようにして得られた電着塗装液を用いて前記したスルーホール内壁及び基板表面に銅層を有する基板への電着塗装は、該基板を陽極として電着塗装液中に浸漬し、通常、定電流法では30 $^{-4}$ 00 $^{-4}$ 00 $^{-4}$ 00 $^{-1}$ 00直流電流を、また、定電圧法では30 $^{-4}$ 00 $^{-1}$ 00直流電圧を10秒 $^{-5}$ 分間印加して行われる。得られた電着塗膜(ネガ型フォトレジスト)の膜厚は5 $^{-5}$ 0 $^{-1}$ 10 $^{-1}$ 20 $^{-1}$ 30

【0035】電着塗装後、電着塗装液から基板を引き上げ、水洗、水切りした後、熱風等で乾燥させる。この際、乾燥温度が高すぎると塗膜が熱硬化し、露光後の現像工程で一部現像残りとなるため、通常、120℃以下で乾燥することが望ましい。

【0036】本発明の製造法では、次に、このようにネガ型フォトレジストを形成したのち、その表面にフォトマスクを設置し、それを介して露光を行う。用いるフォトマスクに描かれているスルーホールに対応する露光部の径(図1の r_2)は、実際のスルーホール径に対し、1.00~3.00倍、好ましくは、1.00~2.00倍、より好ましくは、1.00~1.50倍である(図1)。フォトマスクに描かれているスルーホールに対応する露光部の径が、実際のスルーホール径に対し、3.00倍を超えるとランドが大きくなりすぎて、小径ランドとは程遠くなり、また、1.00倍未満は本発明の範囲外である。

【0037】一つのスルーホールに対し、基板をはさん 50

10

で設置される二枚のフォトマスクのそのスルーホールに 対応する露光部の径は、同一でもよく、また、異なって いてもよい。次いで、フォトマスクを設置する際の位置 合わせについて説明する。位置合わせが重要であること は既述したとおりである。本発明は、この位置合わせの 裕度が極めて広いことが大きな特長である。

【0038】フォトマスクの位置合わせは極力正確に行わなければならないが、本発明はフォトマスクの設置条件を次の2つの場合(a)と(b)を含むこととした点を特徴とする。

(a) フォトレジストを形成した基板の片面に、ある一つのスルーホールに対しフォトマスク中の前記スルーホールに対応する露光部の縁が前記スルーホールの縁から前記スルーホールの内側に向かって前記スルーホール径の20%未満に相当する距離の分ずれてフォトマスクを設置した場合、フォトレジストを形成した前記基板のもう一方の面には、フォトマスク中の前記スルーホールに対応する露光部の縁が、前記スルーホールの縁から、スルーホールの内側に向かって、前記スルーホール径の100%以下に相当する距離の分ずれてフォトマスクを設置する場合。

【0039】図2に上記(a)の場合の概念図を示す。 図2に示す基板の上側の面は、上述のフォトマスク中の スルーホールに対応する露光部の縁が、そのスルーホー ルの縁からスルーホールの内側に向かって、実際の該ス ルーホール径の20%未満に相当する距離の分ずれてフ オトマスクを設置した場合を示す。

【0040】なお、フォトマスクの位置ずれの距離Lは、スルーホールの円の中心点とそのスルーホールに対応するフォトマスクの露光部の円の中心点を結ぶ直線の延長線におけるスルーホールの縁とその縁からスルーホールの内側にずれたフォトマスク露光部の縁との距離をいう(図4)。

【0041】この場合、20%未満とは、 $図2のL_1/r_1$ が20%未満であることを意味し、 L_1 =0の場合(図3の(ア))、さらには、図3の(イ)及び(ウ)に示すように、フォトマスクの露光部の円の中心点とスルーホール円の中心点とが一致し、フォトマスク中の該スルーホールに対応する露光部が正しくスルーホールに設置されている場合(イ)や、多少ずれても、スルーホールの内側にまでずれこまない場合(ウ)も含まれる。

【0042】この図3の(ア)、(イ)及び(ウ)の場合は、後述するフォトマスクの位置ずれが「100%以下」「50%以下」という表現の場合にも含まれる。

【0043】図2に示す基板の下側の面では、フォトマスク中の該スルーホールに対応する露光部の縁が、実際のスルーホールの縁から、スルーホールの内側に向かって、実際の該スルーホール径の100%以下に相当する距離の分ずれてフォトマスクを設置した場合を示す。

【0044】この場合、100%以下とは、図2のL2

/ r_1 が 1 0 0 %以下であることを意味し、L=1 . 0 $0 \times r_1$ の場合(図 5)から、前述した図 3 の(ア)、(イ)及び(ウ)の場合までの範囲を意味している。図 5 から分かるように、フォトマスクの露光部の位置ずれが、スルーホール径の 1 0 0 %を超すと、スルーホールは完全なランドレスになる。しかし、それ以上位置ずれが大きくなると、でき上がったプリント配線板上には、フォトマスクの露光部径に相当する不要な銅層の部分が、スルーホールから離れて形成され、この部分がスルーホール近くに形成された銅の配線ラインと重なってしまったり、また、該スルーホールと銅のラインとの接続が保てなくなる等の問題がでてくる。したがって、本発明では、フォトマスクの露光部の位置ずれは、該スルーホール径の 1 0 0 %が上限である。

【0045】また、基板をはさんだ上下両面におけるフォトマスクの同一スルーホールに対する位置ずれの方向は、同一でも、異なっていてもよい。このことは、後述する(b)の場合にも当てはまる。

【0046】いずれにしても本発明は、(a)の場合のように、一方の面のフォトマスクの位置ずれが少ない場合は、他方の面では、実際のスルーホールからフォトマスクの露光部が完全にずれて、その他方の面からは光がスルーホール内部に照射されなくても、スルーホールの内壁の銅は完全に確保できるという大きな特長を有している。これにより、スルーホールの一部がランドレス又は完全なランドレスが達成できる。

【0047】本発明はフォトマスクの設置条件で上記の(a)の場合の他に、次の(b)の場合も含む。

(b) フォトレジストを形成した基板の片面に、ある一つのスルーホールに対しフォトマスク中の前記スルーホールに対応する露光部の縁が前記スルーホールの縁から前記スルーホールの内側に向かって前記スルーホール径の20~50%に相当する距離の分ずれてフォトマスクを設置した場合、フォトレジストを形成した前記基板のもう一方の面には、フォトマスク中の前記スルーホールに対応する露光部の縁が、前記スルーホールの縁から、スルーホールの内側に向かって、前記スルーホール径の50%以下に相当する距離の分ずれてフォトマスクを設置する場合。

【0048】図6に上記(b)の場合の概念図を示す。図6に示す基板の上側の面は、上述のフォトマスク中のスルーホールに対応する露光部の縁がスルーホールの縁から、スルーホールの内側に向かって、このスルーホール径の20~50%に相当する距離の分ずれてフォトマスクを設置した場合を示す。

【0049】なお、フォトマスクの位置ずれの距離 L_1 及び L_2 は、(a) の場合と同様に、スルーホールの円 の中心点とそのスルーホールに対応するフォトマスクの 露光部の円の中心点を結ぶ直線の延長線におけるスルー ホールの縁とその縁からスルーホールの内側にずれたフ 50 12

オトマスク露光部の縁との距離をいう(図4)。

【0050】上述の $20\sim50$ %とは、図 $60L_1/r_1$ が $20\sim50$ %であることを意味している。このとき、図6に示す基板の下側の面では、フォトマスク中のスルーホールに対応する露光部の縁が、実際のスルーホールの縁から、スルーホールの内側に向かって、実際のスルーホール径の50%以下に相当する分ずれてフォトマスクを設置した場合を示す。この場合、50%以下とは、図 $60L_2/r_1$ が50%以下であることを意味し、 $L_2=0.50\times r_1$ の場合から、前述した図30(ア)、(イ)及び(ウ)の場合までの範囲を意味している。

【0051】基板をはさんだ上下両面におけるフォトマスクの同一スルーホールに対する位置ずれの方向は、同一でも、異なっていてもよいことは(a)の場合と同様である。

【0052】本発明は、(b)の場合のように、一つのスルーホールに対して、基板をはさんだ両面で、フォトマスクの設置位置がずれても、その位置ずれがスルーホールの内側に向かって、共に50%以下であれば、スルーホール内壁の銅は完全に保護できるという大きな特長を有している。これにより、スルーホールの一部がランドレス化できる。

【0053】本発明は、このように、(a)及び/又は(b)の条件でフォトマスクを設置することが特徴である。続いて本発明の製造法は、このようなフォトマスクを介して露光を行い、電着塗装で形成したネガ型フォトレジストの露光部を光硬化させる。活性光線の光源としては、波長300~450nmの光線を発するものであれば制限はなく、超高圧水銀灯、高圧水銀灯、メタルハライドランプ、キセノンランプ等が好ましく用いられる。

【0054】この際、スルーホール内の露光を効率よく 行うために、基板に対し斜めに光を照射する方式(基板 もしくは光源を移動させながら照射を行う、基板と光源 の間に特殊な光学素子(レンズ等を含む)を設ける等) で露光を行うことが好ましい。

【0055】 露光量は、30~1, 000mJ/cm²が好ましく、80~300mJ/cm²がより好ましい。露光量が 30mJ/cm²未満では、フォトレジストの光硬化が不十分で、良好なレジストパターンが形成できず、また、露光量が 1, 000mJ/cm²を超えると、レジストパターンの解像度が低下し好ましくない。

【0056】次の現像工程は、塗膜(フォトレジスト)の未露光部を現像液により除去する工程である。現像液には、通常、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ水溶液が一般に用いられるが、フォトレジストの材料によっては、乳酸、酢酸等の酸水溶液も用いられ、これらの液を吹きつけるか、アルカリ水溶液もしくは酸水溶液に浸漬するなどして行うことができる。

【0057】次いで、上記の工程後の基板をエッチング

工程に移し、現像により露出した銅の部分を除去する。 エッチング液には、塩化第二銅、塩化第二鉄等を含む酸 エッチング液が一般的に用いられるが、もちろん、フォ トレジストの材料によっては、アンモニア、水酸化ナト リウム等を含むアルカリエッチング液を用いてもよい。 これらの液を、前記基板に吹きつけるか、前記基板をエッチング液に浸漬するなどして行われる。

【0058】最後のレジスト剥離工程は、前記基板表面 及びスルーホール内のレジストを除去し、その下の銅を 露出させる工程である。レジストの剥離に際しては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、メタケイ酸ナトリウム等を含む強アルカリ水溶液、乳酸、酢酸、硫酸等を含む酸水溶液、ハロゲン系、アルコール系、ケトン系などの有機溶剤等を前記基板に吹きつけるか、前記基板をそのような剥離液に浸漬するなどして行われる。このような基本工程により、本発明になるプリント配線板が製造される。

[0059]

【実施例】以下に実施例によって、本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらによって制限されるもの 20 ではない。

【0060】 [電着塗装液の作製] 撹拌機、環流冷却

器、温度計、滴下ロート及び窒素ガス導入管を備えたフ ラスコにプロピレングリコールモノプロピルエーテル 1,130gを加え、撹拌しながら窒素ガスを吹き込み 90℃に加温した。温度が90℃で一定になったところ で、メタクリル酸169g、メチルメタクリレート52 0g、エチルアクリレート140g、2-エチルヘキシ ルアクリレート171g及びアゾビスイソブチロニトリ ル9gを混合した液を2.5時間かけてフラスコ内に滴 下し、その後90℃で撹拌しながら3時間保温した。3 時間後にアゾビスジメチルバレロニトリル2.5gをプ ロピレングリコールモノプロピルエーテル100gに溶 かした溶液を10分かけてフラスコ内に滴下し、その後 再び90℃で撹拌しながら4時間保温した。得られたポ リマーの重量平均分子量は4,4000、酸価は11 0、ポリマー溶液の固形分は45.7重量%であった。 【0061】このポリマー溶液650gにペンタエリス リトールトリアクリレート(新中村化学株式会社製、U 30g及びN, N'ーテトラエチルー4, 4'ージアミ ノベンゾフェノン2gを加えて溶解した。この溶液にト リエチルアミン20gを加えて溶解し、溶液中のポリマ ーを中和した。この溶液を撹拌しながらイオン交換水 4,200gを徐々に滴下しながら加えて、ネガ型感光 性電着塗料樹脂組成物を含む電着塗装液を作製した。こ

【0062】実施例 $1\sim9$ 及び比較例 $1\sim4$ 次に、板厚約 $0.2\sim1.0$ mmのガラスエポキシ銅張積 層板(銅箔の厚み 35μ m)に、銅めっき(めっき厚2

の電着塗装液のpHは7.6であった。

14

 5μ m) されたスルーホールを50 個有する基板(実施例 $1 \sim 7$ 及び比較例 $3 \sim 4$)、もしくは、フィルム厚約 $0.05 \sim 0.10$ mmのポリイミドフィルムの両面に 9μ mの銅箔を設けた基板に、銅めっき(めっき厚 10μ m) されたスルーホールを50 個有する基板(実施例 $8 \sim 9$)及び本発明の範囲外である板厚約1.6 mのガラスエポキシ銅張積層板(銅箔の厚み 35μ m)に、銅めっき(めっき厚 25μ m)されたスルーホールを50 個有する基板(比較例 $1 \sim 2$)を、それぞれ上述の電着塗装液の中に陽極として浸漬した。

【0063】陰極には陽極と同一面積のステンレス板を用い、極間距離 $150\,\mathrm{mm}$ として陽極をはさむ形で設置した。基板(陽極)に振動及びよう動を5分間加えたのち、電着塗装液を $25\,\mathrm{C}$ に保温した状態で、 $80\,\mathrm{mA/dm^2}$ の直流電流を $120\,\mathrm{D}$ 間印加し、基板表面及びスルーホール内にネガ型フォトレジトを電着塗装した。電着塗装液から引き上げた基板を水洗し、乾燥($110\,\mathrm{C}$ 、 $10\,\mathrm{C}$)を行った。得られたネガ型フォトレジストの膜厚は、どの基板も約 $12\,\mathrm{C}$ 15 μ mの範囲内であった。

【0064】この基板の両面に、各スルーホールに対応する露光部を設けたフォトマスクを表1に示す条件(実施例1~9及び比較例1~4)で各スルーホール上に設置した。表中、フォトマスクの位置ずれとは、既述したように、図2又は図6に示す $L_1/r_1 \times 100$ (上面)及び $L_2/r_1 \times 100$ (下面)を表わす。このフォトマスクを介して、光源の下にレンズを有し、スルーホール内に効率よく照射できる露光装置(光源はメタルハライドランプ)により両面同時に300 m_1/m_2 の光量を露光した。

【0065】その後、1重量%の炭酸ナトリウム水溶液で現像した。次いで、上記の基板を塩化第二銅を含む45℃の酸エッチング液で3分間エッチングを行い、さらに5重量%の水酸化ナトリウム水溶液によりレジスト剥離を行った。得られた基板のスルーホールの不良率(エッチング工程でスルーホール内の銅が欠損したスルーホールの全スルーホール50個中の比率)を表1に示した。

【0066】比較例5~6

前述の電着塗装液を作製する際に用いたものと同じ材料及び組成の溶液(トリエチルアミンを加えて、ポリマーを中和する前の溶液)を、 75μ mの厚みのマイラーフィルム上にアプリケーターを用いて塗工し、110で 15分間の乾燥を行い、フォトレジストの膜厚 40μ m の感光性フィルムを作製した。

【0067】この感光性フィルムを、実施例1~2で用いたものと同じ銅めっきされたスルーホールを50個有する基板の両面にそれぞれラミネートした。このようにして、両面に感光性フィルムを積層した基板の両面に、各スルーホールに対応する露光部を設けたフォトマスクを表1に示す条件で各スルーホール上に設置した。この

フォトマスクを介して、3kWの超高圧水銀灯により両面 同時に150mJ/cm²の光量を露光した。

【0068】その後は、レジスト上のマイラーフィルム を剥離した後実施例と同じ条件で、現像、エッチング及 びレジスト剥離を行った。得られた基板のスルーホール の不良率を表1に示した。

【0069】比較例7~8

撹拌機、環流冷却器、温度計、滴下ロート及び窒素ガス 導入管を備えたフラスコにジオキサン904gを加え、 撹拌しながら窒素ガスを吹き込み、90°Cに加温した。 温度が90℃で一定になったところで、メタクリル酸8 6. 4g、メチルメタクリレート264g、n-ブチル アクリレート370g、2-ヒドロキシエチルアクリレ ート79.6g及びアゾビスイソブチロニトリル8gか らなる混合物を、2.5時間かけてフラスコ内に滴下 し、その後、90℃で撹拌しながら3時間保温した。3 時間後にアゾビスイソブチロニトリル2. 4gをジオキ サン80gに溶かした溶液を10分かけてフラスコ内に 滴下し、その後再び90℃で撹拌しながら4時間保温し た。このようにして得られた樹脂の重量平均分子量は5 6,000、酸価は72、ポリマー溶液の固形分は4 4. 6 重量%であった。

【0070】一方、ポジ型感光剤の合成を下記のように 行った。没食子酸nープロピル63.6g及び1,2-ナフトキノン-2-ジアジド-5-スルホニルクロリド 161.1gをジオキサン1,500gに溶かした溶液 を撹拌しながら40℃に加温し、これにトリエチルアミ ン63gを50分かけて滴下した。滴下後、40℃でさ らに5時間反応させた後、反応物を0.1Nの塩酸水溶 液に注入し、得られた沈殿物を精製、ろ過して、ポジ型 30 ホールの不良率を表1~2に示した。 感光剤である没食子酸 n - プロピルと 1, 2 - ナフトキ ノン-2-ジアジド-5-スルホン酸とのエステル化合 物165gを得た。

16

【0071】上記のポリマー溶液850g、ポジ型感光 剤100g及びトリエチルアミン29gを混合し、得ら れた溶液を撹拌しながらイオン交換水3,800gを徐 々に滴下しながら加えて、ポジ型感光性電着塗料樹脂組 成物を含む電着塗装液を作製した。この電着塗装液のpH は7.9であった。次に、実施例1~2で用いたものと 同じ銅めっきされたスルーホールを50個有する基板 を、それぞれ上述のポジ型電着塗装液の中に陽極として 浸漬した。

【0072】陰極には陽極と同一面積のステンレス板を 用い、極間距離150mmとして陽極をはさむ形で設置し た。基板 (陽極) に振動及びよう動を 5 分間加えたの ち、電着塗装液を25℃に保温した状態で、120 Vの 直流電圧を120秒印加し、基板表面及びスルーホール 内にポジ型フォトレジストを電着塗装した。電着塗装液 から引き上げた基板を水洗し、乾燥(100℃、10 分)を行った。得られたポジ型フォトレジストの膜厚 は、どの基板も約8~9μmの範囲内であった。

【0073】この基板の両面に、図7に示す各スルーホ 20 一ルに対応する非露光部(ネガ型フォトレジストの場合 とは逆に、スルーホール内を露光しないように、フォト マスクの白黒が反転している)を設けたフォトマスクを 表1に示す条件(表中、フォトマスクの位置ずれは図7 に示す L_1' / $r_1 \times 100$ (上面) 及び L_2' / $r_1 \times 1$ 00 (下面)を表わす)で、各スルーホール上に設置し た。このフォトマスクを介して、比較例5~6で用いた 超高圧水銀灯により両面同時に350mJ/cm2の光量を露 光した。その後は、実施例と同じ条件で、現像、エッチ ング及びレジスト剥離を行った。得られた基板のスルー

[0074]

【表1】

•	-	4	
1	ı	,	

				表 1			
	越板の厚めの	_04€ 	スルーホール径 (mm)	フォトマスクの露光 2) フォトマの露光 2) フォトマの 露光 部 経 の 位置 (****)	スギクれ	24-4-7の不良率(26)	ランドレスの 状
				(1		(0/)	一種ルンドアコ
実施例 1		ာ ၀	0.35	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	0	ソドファフ
中校師の		u c	2	0.80(1.60) 3	0		部ランドフ
米属包 4	·	ဂ ၁		面0.50(1.00) 4	0	-	一部ランドレス
中特徴で	C	O L	0 0	40(2.00)	3)		ンで有
火角をつい	•			面0.30(1.50) 10	0	>	完全ランドレス
中華四月	ح	n,	о С	11(1.31)	5		一部ランドレス
天魔初生				面0.94(1.11) 8	0	-	一部シンドレス
中春節口	c	r.	ر م	0(1.60)	0	c	部ツン
<u> </u>			٥.	面0.30(1.20) 6	0	>	一部ランドレス
中体面に	c	T.	0 7 0	0.72(1.80) 4	0	0	一部ランドレス
N. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	•		t •	面0.60(1.50) 3	0	>	一部ランドレス
1 四 料 本	C	9 6	06 0		0	c	一部ランドレス
X IN DO	•			面0.22(1.10) 3	0	>	一部ランドレス
金を配め	c	r.	0	. 22(2, 20)	3)	C	ランド有り
o ta sw K	•	- 1	•	面0.14(1.40) 8	0	>	部ランドレ
まるので	c	0	ر د	0.12(2.40)	5	c	一部ランドレス
X 46 73 V	- 1		•	面0.08(1.60) 9	0	>	ソドフ

注1) 基核の厚め 2) 実務例 1~ また、 (3) 欄中の一に ただし、フ

18

み:めっき銅の厚みを含めた全厚み ~9及び比較例1~6は露光部径を、比較例7~8の場合は非露光部径を表わす。)内は、スルーホール径に対するフォトマスクの露光部又は非露光部径の倍率を表わす。 は、スルーホール内側へのフォトマスクの位置ずれはないことを示す。 スルーホール円の中心点とフォトマスクの露光部もしくは非露光部円の中心点とが一致し、 トマスクの位置ずれがないということでは必ずしもない。

19

	シンドレスの来	製価に値せず	習首に値やす	背角に値よず	製価に値やず	スプーキール 形 成 木 旦	スルーホール形成を内	ドーボー 成	3	むす。 倍 略 を 表 た が 一致
	スルーキールの不良を	8 0	7 0	7 0	0 9	100	100	100	100	非職光 は非職光部 とや引す。 職光乾田の「
	フォトマスク の 位置 ずれ (%)	1 0 8 5	3 0 4 0	6 0 6 0	4 0 8 0	1 0 1 0	_ 3) 1 0	1 0 1 0	1 0	88ののものののでは、1900ののでは、1900のでは、1
表 2	フォトマスクの電光 2): 部又は非露光部径 (m)	上面0.53(1.51) 下面0.53(1.51)		上面0.53(1.51) 下面0.53(1.51)	上面0,72(1,80) 下面0,60(1,50)	上面0.53(1.51) 下面0.53(1.51)	上面0.80(1.60) 下面0.50(1.00)	上面0.53(1.51) 下面0.53(1.51)	上面0.80(1.60) 下面0.50(1.00)	はのたか原原の大のではのために対するでのフォトではたなけられたなからのフォトスからないといったとなったいというにいいにいいたい
	スルーホール径 (mm)	0.35	0.50	0.35	0.40	0.35	0.50	0.35	0.50	な動の厚みを に放倒1~6 に 、スルーホーン ・ナールの例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	基板の 1) 厚 み (皿)	1.65	1.65	1.05	0.55	1.05	1.05	1.05	1.05	の両や:めつ 第1~9及び、() 内保 の一は、メル し、メルーホ フォトマメク
		比較例 1	比較例2	比較例3	比較例4	比較例 5	比較例6	比較例7	比較例8	注(1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7

【0075】表1から、フォトレジストの形成が感光性フィルムの積層による場合(比較例5~6)及びポジ型フォトレジストを電着塗装で形成した場合(比較例7~8)は、共に、フォトマスクの位置ずれに対する裕度は全くなく、基板の上下、どちらか一方の面でフォトマスクがわずか(10%)にずれても、スルーホール内の銅は欠損してしまい、全てのスルーホールが不良となることが分かる。

【0076】また、ネガ型フォトレジストを電着塗装で形成した場合でも、本発明の範囲外である基板の厚みが厚い場合(比較例1~2)や、フォトマスクの露光部がスルーホールの内側に大きくずれた状態で設置した場合には、かなりの割合のスルーホールで、内部の銅の欠損が見られ、不良率は高い。もちろん、このため完全なランドレスもしくは一部ランドレスのスルーホールは形成できない。これに対し、本発明の範囲内である実施例1

~9では、スルーホールの不良が皆無であり、かつ、完全なランドレスもしくは一部ランドレスのスルーホールの形成が可能であることが分かる。

【0077】次に、フォトマスクの位置合わせに要する時間を比較した。一枚の基板にある50個のスルーホール全てに対して、本発明になる(a)又は(b)の条件内でフォトマスクを基板の両面に設置するに要する時間と、比較例5~8に示した感光性フィルムやポジ型フォ*

*トレジストを電着塗装で形成した場合などのように、フォトマスクの露光部がスルーホールの内側にわずかでもずれこまないように、図3の(イ)又は(ウ)の条件内でフォトマスクを基板の両面に設置するに要する時間を、実施例1、3及び8に示した基板及びフォトマスクを用いた場合について比較した。結果を表3に示す。

22

[0078]

【表3】

表

	711 + 11			フォトマスクの設置時間(名		設置時間(分) 1)
	スルーホール 径 (mm)	フォトマスクの 露光部径(mm)	(a)又は(b)の 条件内	(イ)又は(ウ)の 条件内		
実施例		上面 (0.53 (1.51)		9. 5		
1	0.35	下面 0.53 (1.51)	3.4	J. J		
実施例	0.20	上面 (2.40(2.00)	4.5	16.2		
3	0.20	下面 0.30 (1.50)	4. 0	10, 2		
実施例	0 10	0.10 上面 (2.20) 6.2	6 2	28.5		
8	0.10	下面 0.14	6.2	20.5		

注1) 各1()回試みた結果の1回の平均所要時間(分)

【0079】表2より、フォトマスクの正確な位置合わ 30 せに要する時間は、スルーホール径やフォトマスクの露光部径が小さくなるにつれて著しく増加する。それに対し、本発明におけるフォトマスクの設置条件では、位置合わせ裕度が広いために、どれも短時間でフォトマスクを設置できることが分かる。

[0080]

【発明の効果】本発明によれば、近年の傾向であるプリント配線板の高密度化に対応するための小径スルーホール形成にとって、従来から厳しかったフォトマスクの位置ずれ裕度が大幅に緩和されるため、フォトマスクの位置合わせのために要する時間が大幅に短縮され、また、スルーホールの不良率が著しく向上するという特長がある。また、本発明の製造法は、完全なランドレスもしくは一部ランドレスのスルーホールを形成できるため、今後のより高密度プリント配線板の製造に極めて有効である。本発明の製造法は、リジッドプリント配線板、フレキシブルプリント配線板の製造はもとより、TAB(Tape Automated Bonding)、MCM(Multi Chip Module)など、広い意味でのプリント配線板の製造に適用で

o きる。

【図面の簡単な説明】

【図1】スルホールとフォトマスクを示した模式図。

【図2】フォトマスクの設置条件(a)を示した概念 図

【図3】フォトマスクの露光部とスルホールの位置関係を示した模式図。

【図4】フォトマスクの位置ずれ距離しを示した図。

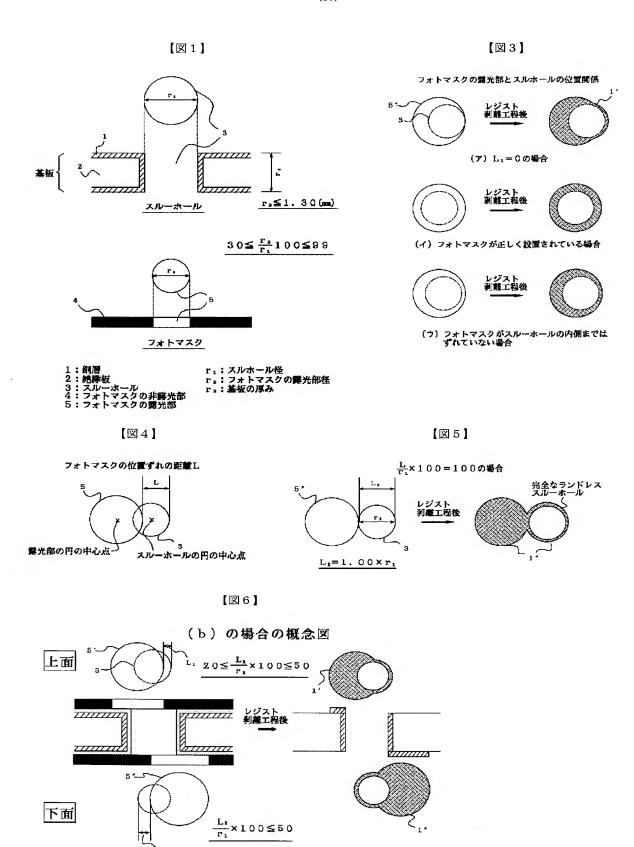
【図5】フォトマスクの露光部の位置ずれが、スルホール径の100%を超す場合の模式図。

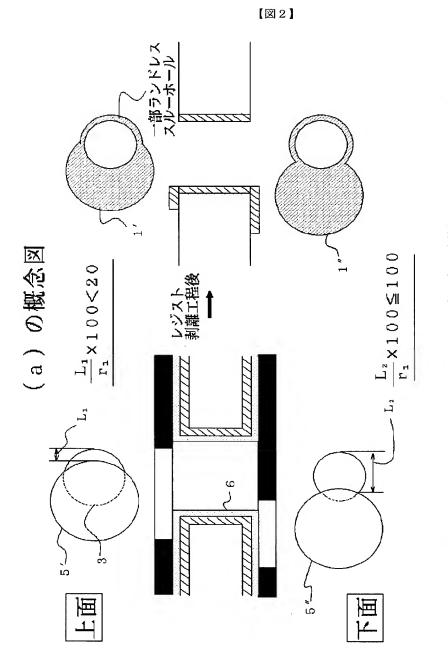
40 【図 6 】 フォトマスクの設置条件(b) を示した概念 図

【図7】比較例7~8の場合を示した模式図。 【符号の説明】

1 銅層

- 2 絶縁板
- 3 スルーホール
- 4 フォトマスクの非露光部
- 5 フォトマスクの露光部



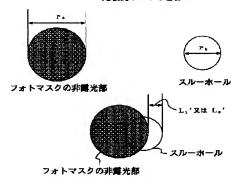


L.: 基板上面におけるフォトマスクの露光部の稼がスルーホールの稼から内側にずれた距離L。: 基板下面におけるフォトマスクの露光部の稼がスルーホールの稼から内側にずれた距離

(15)

【図7】

比較例7~8の場合



R4: フォトマスクの非觸光部径 L1': 基板上面におけるフォトマスクの非質光部の縁が スルーホールの無から内側にずれた距離 L2': 基板下面におけるフォトマスクの非常光部の縁が スルーホールの縁から内側にずれた距離

フロントページの続き

上原 秀秋		(72)発明者	山田 正治	
茨城県日立市東町四丁目13番1号	日立化		栃木県大田原市下石上1382番12号	大日本
成工業株式会社茨城研究所内			塗料株式会社那須工場內	
天野倉 仁		(72)発明者	山崎 雄治	
茨城県日立市東町四丁目13番1号	日立化		栃木県大田原市下石上1382番12号	大日本
成工業株式会社茨城研究所内			塗料株式会社那須工場内	
加藤 琢郎		(72)発明者	塩谷 俊彦	
茨城県日立市東町四丁目13番1号	日立化		栃木県大田原市下石上1382番12号	大日本
成工業株式会社山崎工場内			塗料株式会社那須工場内	
塚田 勝重		(72)発明者	長島 義久	
茨城県日立市東町四丁目13番1号	日立化		栃木県大田原市下石上1382番12号	大日本
成工業株式会社山崎工場内			塗料株式会社那須工場内	
	茨城県日立市東町四丁目13番1号 成工業株式会社茨城研究所内 天野倉 仁 茨城県日立市東町四丁目13番1号 成工業株式会社茨城研究所内 加藤 琢郎 茨城県日立市東町四丁目13番1号 成工業株式会社山崎工場内 塚田 勝重 茨城県日立市東町四丁目13番1号	茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化成工業株式会社茨城研究所内 天野倉 仁 茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化成工業株式会社茨城研究所内加藤 琢郎 茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化成工業株式会社山崎工場内 塚田 勝重 茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化	茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化 成工業株式会社茨城研究所内 (72)発明者 天野倉 仁 (72)発明者 茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化 成工業株式会社茨城研究所内 (72)発明者 茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化 成工業株式会社山崎工場内 (72)発明者 塚田 勝重 (72)発明者 茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化	茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化 栃木県大田原市下石上1382番12号 成工業株式会社茨城研究所内 塗料株式会社那須工場内 天野倉 仁 (72)発明者 山崎 雄治 茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化 栃木県大田原市下石上1382番12号 成工業株式会社茨城研究所内 塗料株式会社那須工場内 加藤 琢郎 (72)発明者 塩谷 俊彦 茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化 栃木県大田原市下石上1382番12号 成工業株式会社山崎工場内 塗料株式会社那須工場内 塚田 勝重 (72)発明者 長島 義久 茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化 栃木県大田原市下石上1382番12号